

关键指标

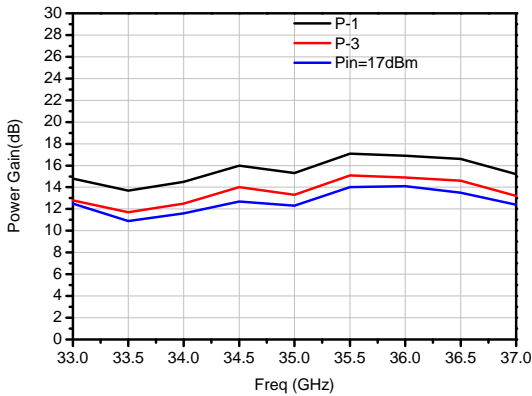
频率: 34~37GHz
 功率增益: 14dB
 1dB 压缩点输出功率: 27dBm
 功率附加效率: 20%
 电压/电流: +5V/530mA
 芯片尺寸: 2.44mm×2.2mm×0.1mm

电性能 (T_A=25°C, V_{dd}=+5V, V_g=-1V)

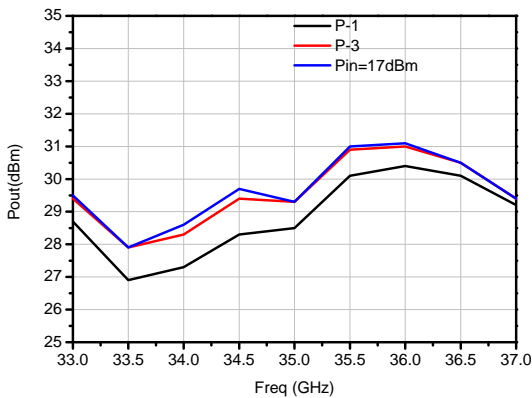
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	34~37		
功率增益(dB)	-	14	-
增益平坦度(dB)	-	±0.6	-
输入驻波	-	2	-
输出驻波	-	1.8	-
1dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	27	-
功率附加效率	-	20%	-
静态电流 (mA)	-	530	-

典型测试曲线 (V_{dd}=+5V)

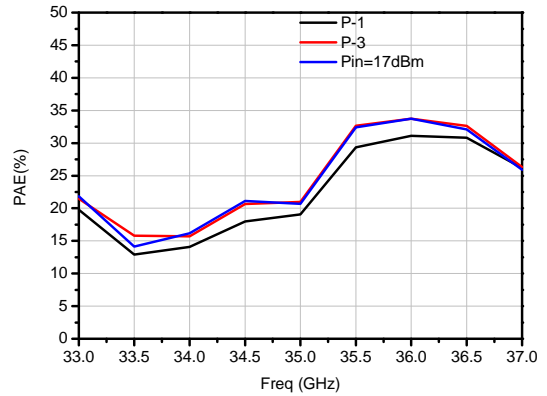
功率增益@5V



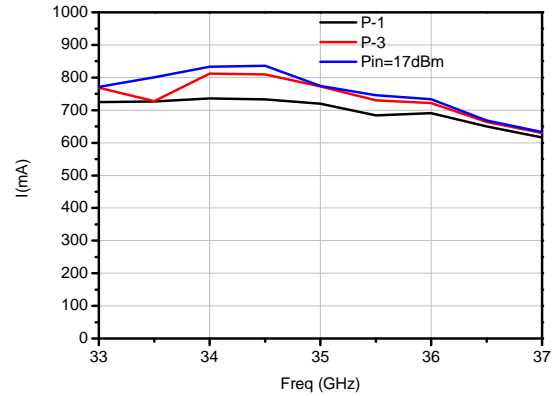
输出功率@5V



功率效率@5V

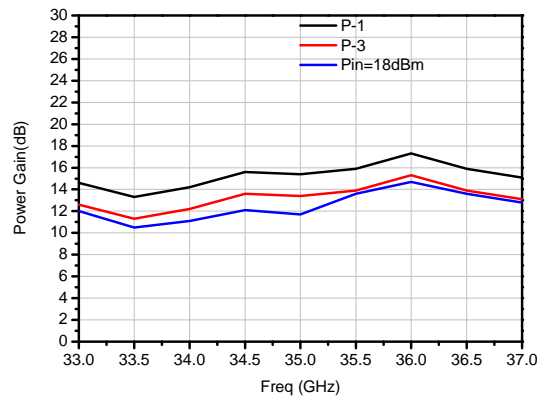


工作电流@5V

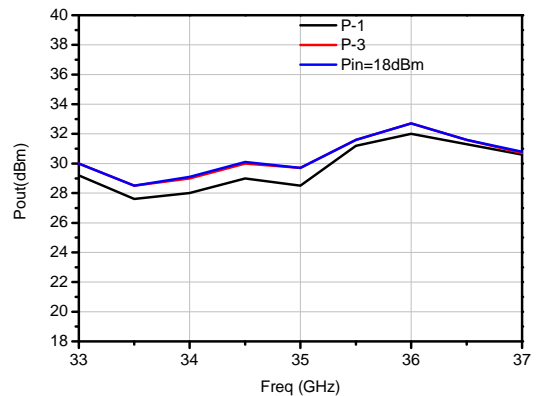


典型测试曲线 (V_{dd}=+6V)

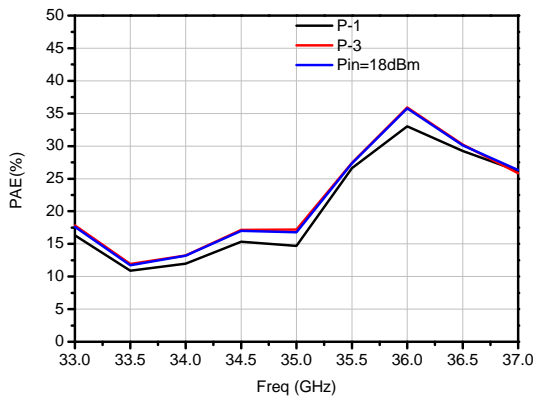
功率增益@6V



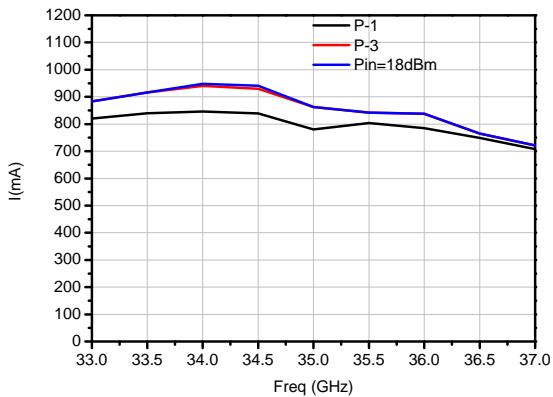
输出功率@6V



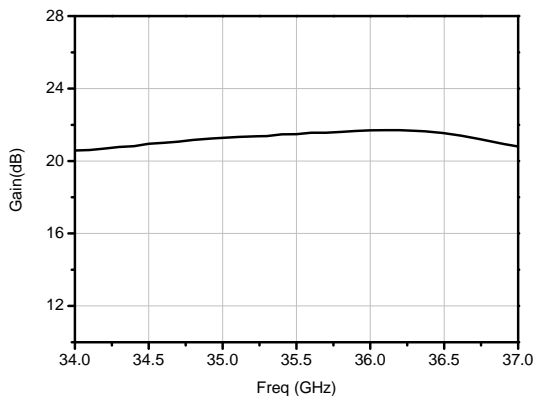
功率效率@6V



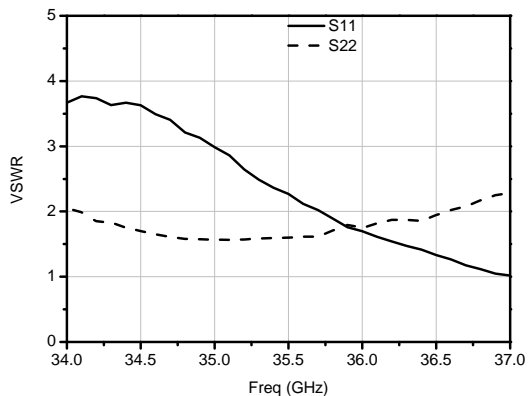
工作电流@6V



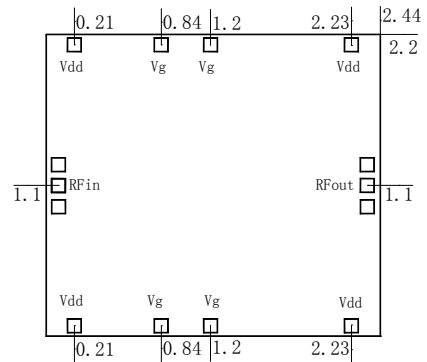
增益



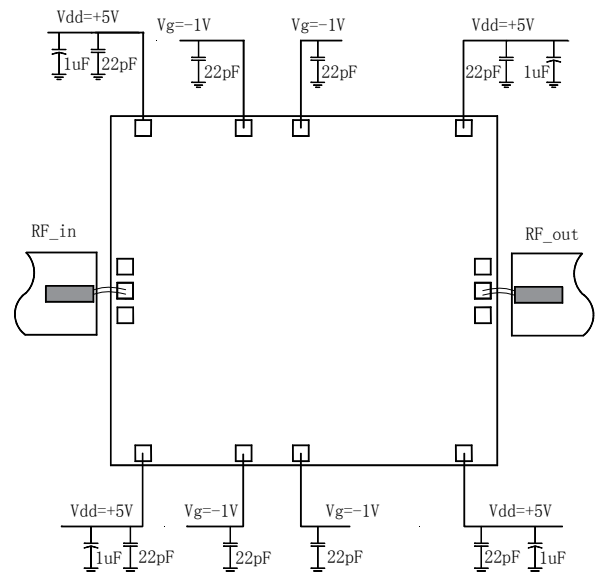
驻波



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+8V
最大输入功率	+25dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。